



Maßbild mit Anschlußbelegung

Gehäuse: SOT-89

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren für Anwendungen in der Hybrid- und Aufsetztechnik.

Mit Komplementärtypen SFE 570 anwendbar in den Video-B-Endstufen.

Grenzwerte

Grenzwert	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Kollektor-Basis-Spannung	U_{CBO}		250	V
Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CEO}		250	V
Emitter-Basis-Spannung	U_{EBO}		5	V
Kollektorstrom	I_C		50	mA
Kollektorspitzenstrom	I_{CM}		100	mA
Gesamtverlustleistung bei $T_{amb} \leq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ - auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick 2,5 cm ² Fläche	P_{tot}		1	W
Sperrschichttemperatur	T_j		150	°C
Betriebstemperaturbereich	T_{stg}	-55	125	°C

Grenzwerte

Grenzwert	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Wärmewiderstände zwischen Sperrschicht und Umgebung - auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick 2,5 cm ² Fläche	R_{thja}		125	K/W
zwischen Sperrschicht und Kollektor	R_{thje}		25	K/W

Ausgewählte Kennwerte ($T_{amb} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$)

Kennwert	Kurzzeichen	Meßbedingung	min.	typ.	max.	Einheit
Kollektor-Basis-Reststrom	I_{CBO}	$I_E = 0$ $U_{CB} = 200 \text{ V}$			50	nA
Kollektor-Emitter- Restspannung	U_{CEsat}	$I_C = 30 \text{ mA}$ $I_B = 5 \text{ mA}$			0,6	V
Gleichstromverstärkung	h_{FE}	$U_{CE} = 20 \text{ V}$ $I_C = 25 \text{ mA}$	50			
Transit-Frequenz	f_T	$U_{CE} = 10 \text{ V}$ $I_C = 10 \text{ mA}$ $f_M = 20 \text{ MHz}$	60			MHz
Rückwirkungskapazität	C_{12e}	$U_{CE} = 30 \text{ V}$ $I_C = 0$ $f = 1 \text{ MHz}$			1,6	pF